Proponuję żeby Państwo pracowali w zespołach projektowych - jeżeli są osoby które wolałyby inny podział, to proszę o kontakt mailowy.

W tabeli poniżej znajdą Państwo przydział plików:

 z danymi pomiarowymi diody Esakiego (kolumna: dane pomiarowe)- dotyczy punktów 1.1÷1.8 instrukcji wykonawczej,

Komentarz #1:

wartości prądu bliskie 100mA oznaczają włączenie ograniczenia prądowego w jednostce pomiarowo-wymuszającej- mogą Państwo pominąć te punkty przy rysowaniu wykresu, lub narysować i dodać stosowny komentarz w tekście sprawozdania,

Komentarz #2:

żeby narysować wykres w skali pół-logarytmicznej należy zmierzone wartości prądu przeliczyć na wartość bezwzględną.

Komentarz #3:

punkty 1.1 i 1.2 instrukcji (wyprowadzenie wzorów): wyprowadzenia wzorów mogą być napisane odręcznie i w postaci skanów załączone do sprawozdania w formie dodatków.

z parametrami struktury DB MOS- dotyczy punktów 2.2 i 2.3 instrukcji wykonawczej:

Komentarz #1:

 V_x -rozkład potencjału w obszarze x (przyjmujący stałą wartość wewnątrz obszaru),

 b_1 , b_2 - szerokości barier potencjału,

w- szerokość studni potencjału,

Komentarz #2:

zapis w pkt a): "w=1,0 nm/ 1,5 nm/ 2nm"

oznacza, że na jednym rysunku mają znaleźć się trzy krzywe odpowiadające przypadkom,

odpowiednio: w=1,0 nm, w=1,5nm oraz w=2 nm

w analogiczny sposób proszę traktować ten format zapisu wybranych parametrów struktury w pozostałych punktach instrukcji.

Przydział plików:

zespół projektowy	dane pomiarowe	parametry struktury DB MOS
1	1_DT_IV.xls	parametry_DBMOS_#1.pdf
2	2_DT_IV.xls	parametry_DBMOS_#2.pdf
3	3_DT_IV.xls	parametry_DBMOS_#3.pdf
4	4_DT_IV.xls	parametry_DBMOS_#4.pdf
5	3_DT_IV.xls	parametry_DBMOS_#1.pdf
6	2_DT_IV.xls	parametry_DBMOS_#3.pdf
7	1_DT_IV.xls	parametry_DBMOS_#2.pdf